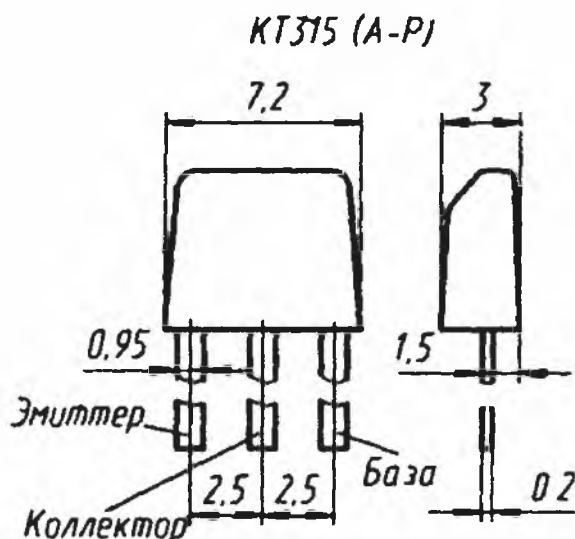


КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усиленные. Предназначены для применения в усилителях высокой, промежуточной и низкой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке, а также на корпусе прибора в виде буквы соответствующего типонаминала.

Масса транзистора не более 0,18 г.

Изготовители — акционерное общество «Кремний», г. Брянск, Нальчинский завод полупроводниковых приборов, г. Нальчик, завод при НИИПП, г. Томск.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 1$ мА:

КТ315А, КТ315В	30...120
КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е	50...350
КТ315Д.....	20...90
КТ315Ж.....	30...250
КТ315И, не менее	30
КТ315Р	150...350

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 1$ мА, не менее..... 250 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{кб} = 10$ В, $I_b = 5$ мА, не более:

КТ315А	300 пс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	500 пс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж.....	1000 пс
КТ315И.....	950 пс

Граничное напряжение при $I_b = 5$ мА, не менее:

КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж	15 В
КТ315В, КТ315Д, КТ315И	30 В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р.....	25 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер	
при $I_k = 20$ мА, $I_b = 2$ мА, не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	0,4 В
КТ315Д, КТ315Е	0,6 В
КТ315Ж.....	0,5 В
КТ315И.....	0,9 В
Напряжение насыщения база—эмиттер	
при $I_k = 20$ мА, $I_b = 2$ мА, не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	1 В
КТ315Д, КТ315Е	1,1 В
КТ315Ж.....	0,9 В
КТ315И.....	1,3 В
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 10$ В,	
не более	1 мкА
Обратный ток коллектор—эмиттер	
при $R_{бэ} = 10$ кОм, $U_{кэ} = U_{кэ, макс}$, не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,	
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р	1 мкА
КТ315Ж.....	10 мкА
КТ315И.....	100 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5$ В для	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д,	
КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р, не более..	50 мкА
Входное сопротивление при $U_{кэ} = 10$ В,	
$I_k = 1$ мА, не менее	40 Ом
Выходная проводимость при $U_{кэ} = 10$ В,	
$I_k = 1$ мА, не более	0,3 мксм
Емкость коллекторного перехода	
при $U_{кб} = 10$ В, не более:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,	
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р	7 пФ
КТ315Ж, КТ315И	10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер	
при $R_{бэ} = 10$ кОм:	
КТ315А	25 В
КТ315Б, КТ315Ж	20 В
КТ315В, КТ315Д	40 В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р.....	35 В
КТ315И.....	60 В
Постоянное напряжение база—эмиттер.....	6 В
Постоянный ток коллектора:	
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,	

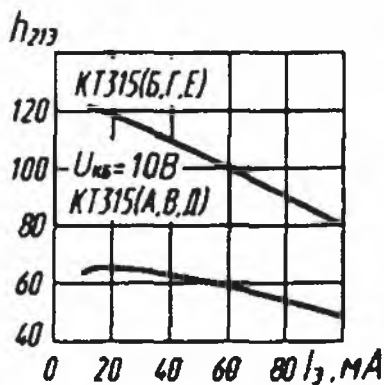
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р 100 мА
 КТ315Ж, КТ315И 50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T \leq +25^\circ\text{C}$:

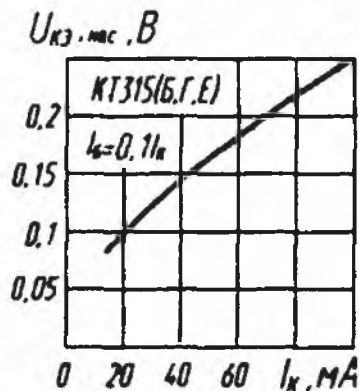
КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,
 КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р 150 мВт
 КТ315Ж, КТ315И 100 мВт

Тепловое сопротивление переход—среда $0,67^\circ\text{C}/\text{мВт}$
 Температура р-п перехода $+120^\circ\text{C}$
 Температура окружающей среды $-60...+100^\circ\text{C}$

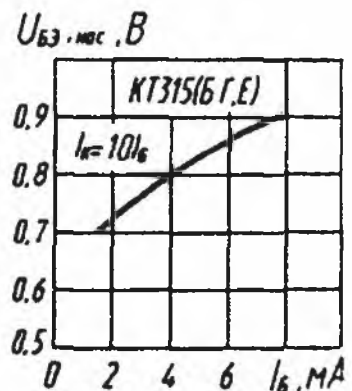
Допускается эксплуатация транзисторов в режиме $P_K = 250$ мВт при $U_{КБ} = 12,5$ В, $I_K = 20$ мА.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока базы